

技術の名称

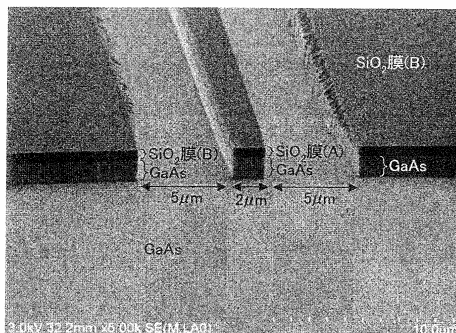
半導体装置の製造方法

適用分野

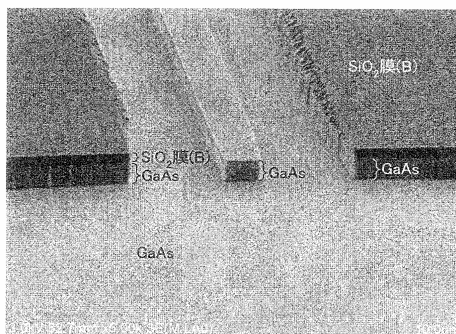
半導体素子、半導体レーザ素子

- 目的 半導体素子の製造の際にマスクとして用いられる酸化シリコン膜を簡単な方法で除去する。
- 効果 酸化シリコン膜の除去には取り扱いや廃棄処理が面倒な弗酸系のエッチャントが不可欠であったが、本発明によればこの弗酸系のエッチャントを用いることなく酸化シリコン膜を除去できるので、廃液処理や取り扱いに要する手間やコストが軽減できる。
- 技術概要 表面の孤立した状態にある酸化シリコン膜を有する基板を有機アルカリ液中に浸漬した後、基板を水などの液体に浸漬して超音波を加え、孤立状態にあった酸化シリコン膜を除去する。

(a)



(b)



■ 特記事項,図など

- 主たる提供特許 特許等の名称 : 半導体装置の製造方法
登録番号 :
出願番号 : 特願2007-076575 出願日 : 平成19年3月23日
公開番号 :

- 実施実績 ○有、無
- 提供形態 ○実施許諾、×権利譲渡

お問合せ先 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 経営統括部 知的財産チーム
〒619-0288 京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2
TEL 0774-95-2521 E-mail ; patent@atr.jp